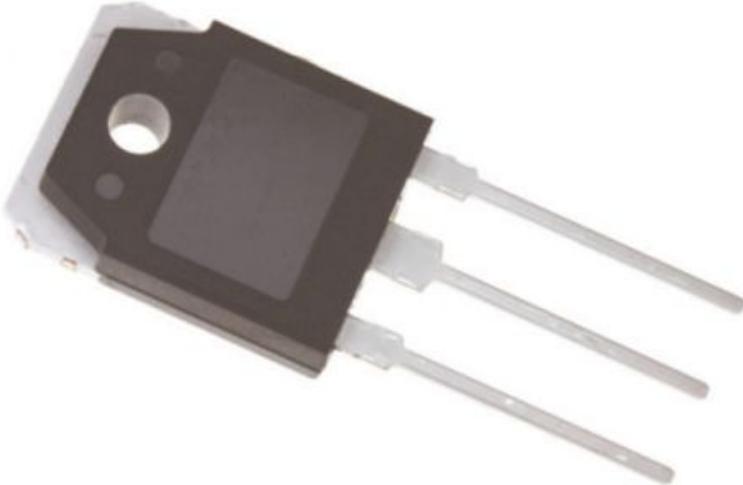




## Transistor FQA9N90C MOSFET N de puissance TO-3PN 900V 9A



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAV9N90C
Alimentation :	Secteur Français

Transistor FQA9N90C MOSFET N de puissance TO-3PN 900V 9A

Remplacé par MOSFET TK9J90E Silicone N-Channel MOS

Courant de drain Id: 9A

Dissipation de puissance Pd: 250W

Tension Vds max...: 900V

Nombre de broches: 3

Résistance Rds(on): 1.3ohm

Température de fonctionnement max..: 150°C

Polarité transistor: Canal N

Tension, mesure Rds: 10V

Tension de seuil : 5V

Tension entrée-source : ±30V

Type de boîtier de transistor: TO-3PN

peut être remplacé par STW11NK90Z

Packaging :
-------------

Dimensions produit :		
----------------------	--	--

Données non contractuelles
----------------------------